

2014年3月期 第1四半期(2013年4月～6月) 東京エレクトロン 決算説明会

内容:

- 第1四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

- 2014年3月期業績予想修正と中期経営計画

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2013年7月30日

第1四半期連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2013年7月30日

業績サマリー

(億円)

	2013年3月期				2014年3月期	対前年 1Q増減
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	1,341	1,324	919	1,387	1,034	-22.9%
売上総利益 下段: 売上総利益率	441 32.9%	415 31.4%	282 30.7%	448 32.3%	299 28.9%	-32.2%
販管費	348	386	351	376	395	+13.6%
営業利益 下段: 営業利益率	92 6.9%	29 2.2%	-68 -7.5%	72 5.2%	-96 -9.3%	—
税前利益	112	43	-61	84	-98	—
当期純利益	57	3	-70	70	-29	—
研究開発費	179	194	174	183	179	+0.4%
設備投資額	76	52	59	29	47	-38.3%
減価償却実施額	55	62	66	82	63	+12.9%

受注は回復基調にあるが、半導体製造装置の売上は谷間の期となった

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

2

部門別売上高

(億円)

	2013年3月期								2014年3月期	
	1Q		2Q		3Q		4Q		1Q	
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
SPE	1,087	81%	1,059	80%	680	74%	1,093	79%	749	72%
FPD	47	4%	44	3%	46	5%	62	4%	49	5%
PVE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	2%
EC/CN	206	15%	218	17%	191	21%	230	17%	214	21%
その他	1	0%	1	0%	0	0%	1	0%	1	0%
合計	1,341	100%	1,324	100%	919	100%	1,387	100%	1,034	100%

SPE
(半導体製造装置)

大手ファウンドリー向け売上の一巡もあり、売上は低下したが、全般的に
期初想定どおりに推移

FPD
(FPD製造装置)

引き続きモバイル端末向け中小型パネル用製造装置の売上が中心

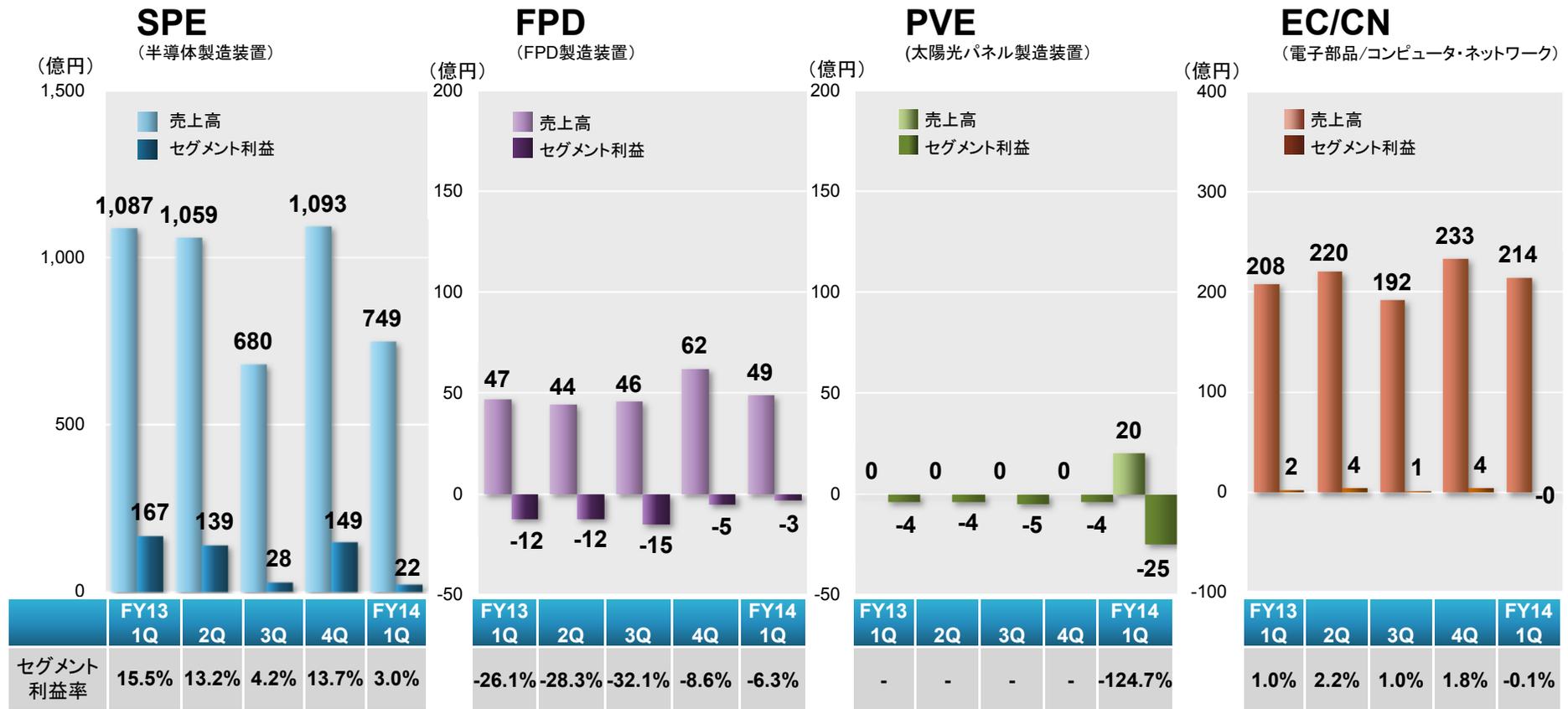
PVE
(太陽光パネル製造装置)

納入済み装置の工事進行基準による売上が中心

EC/CN
(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

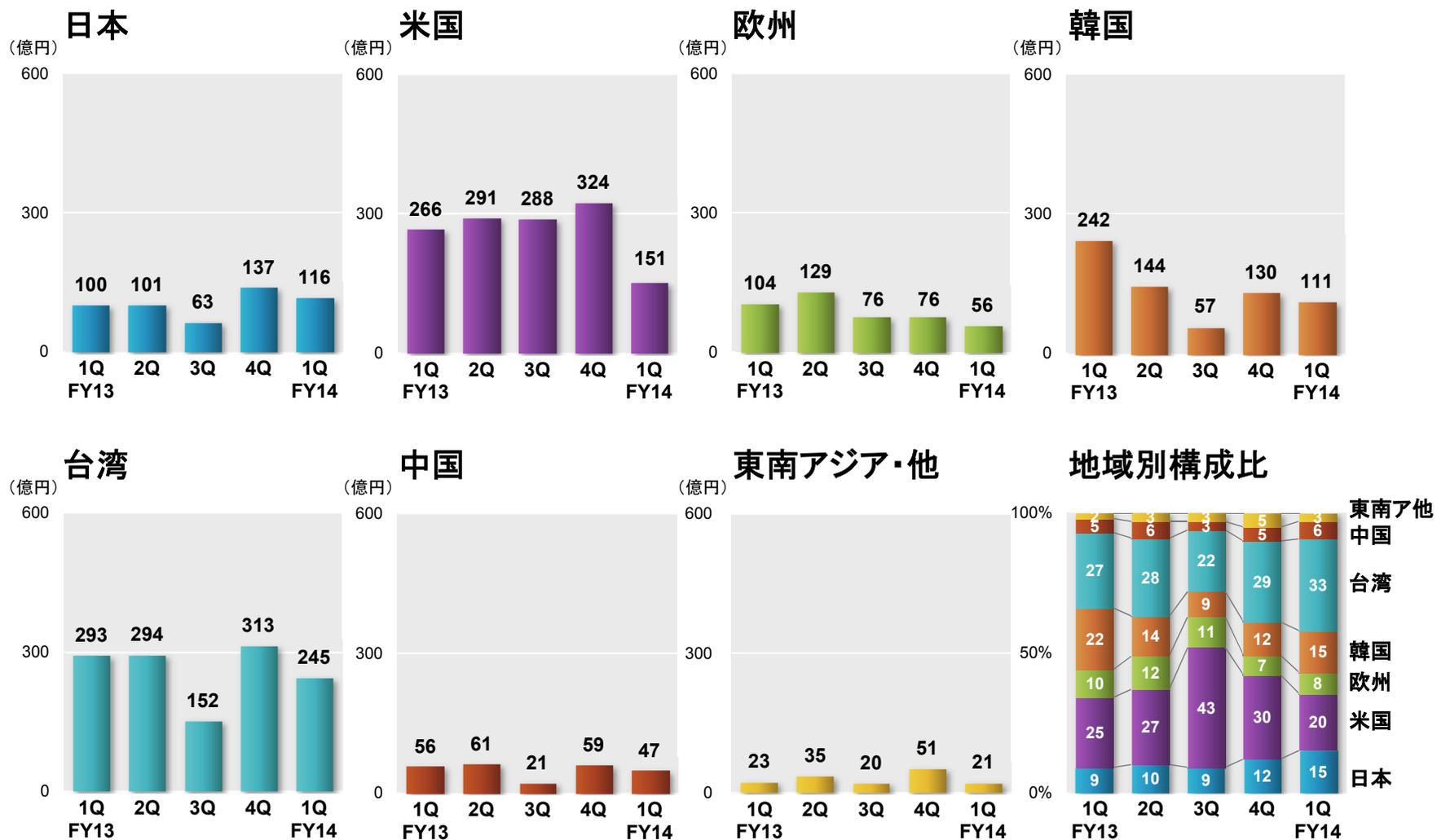
商権拡大により、海外売上が伸長した

セグメント情報



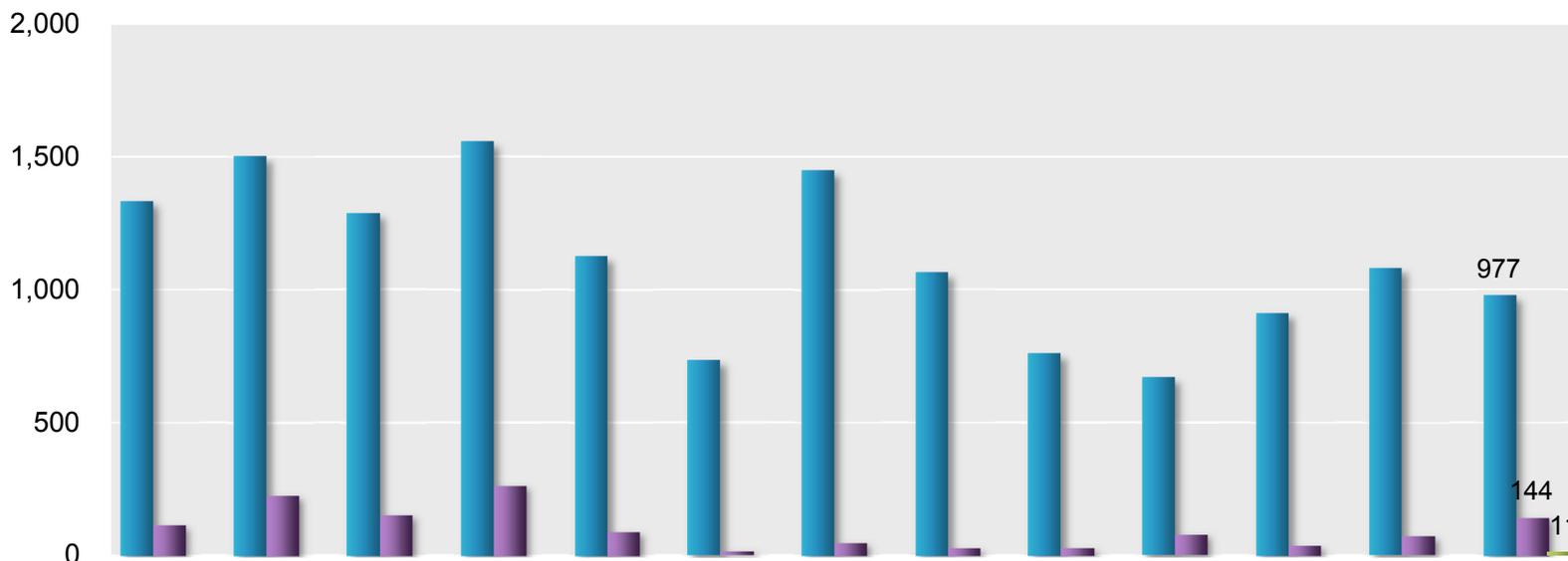
- 従来のFPD/PVEセグメントを、当第1四半期よりFPDとPVEに分けて開示します。それに伴い、FY2013の数字について遡及処理し、表示しています。
- セグメント利益は、税前利益です。
- 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。

SPE部門地域別売上高



受注額・受注残高

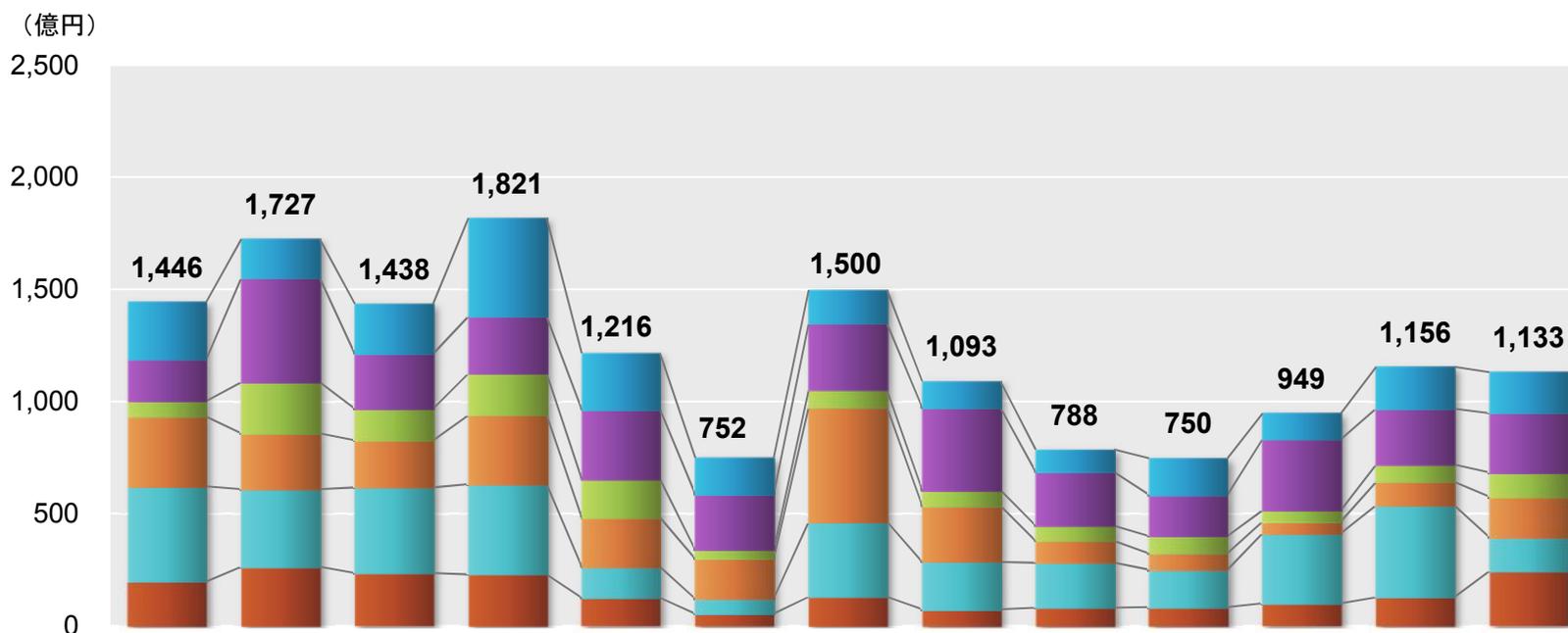
(億円)



	FY11 1Q	2Q	3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q
■ SPE受注額	1,332	1,502	1,286	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977
■ FPD受注額	114	224	152	263	89	17	50	28	27	80	36	73	144
■ PVE受注額									0	0	0	0	11
SPE受注残高	2,023	2,155	2,288	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645
FPD受注残高	479	578	510	654	618	394	278	142	122	158	148	160	255
PVE受注残高									0	-	84	84	76

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

地域別受注額：SPE+FPD+PVE

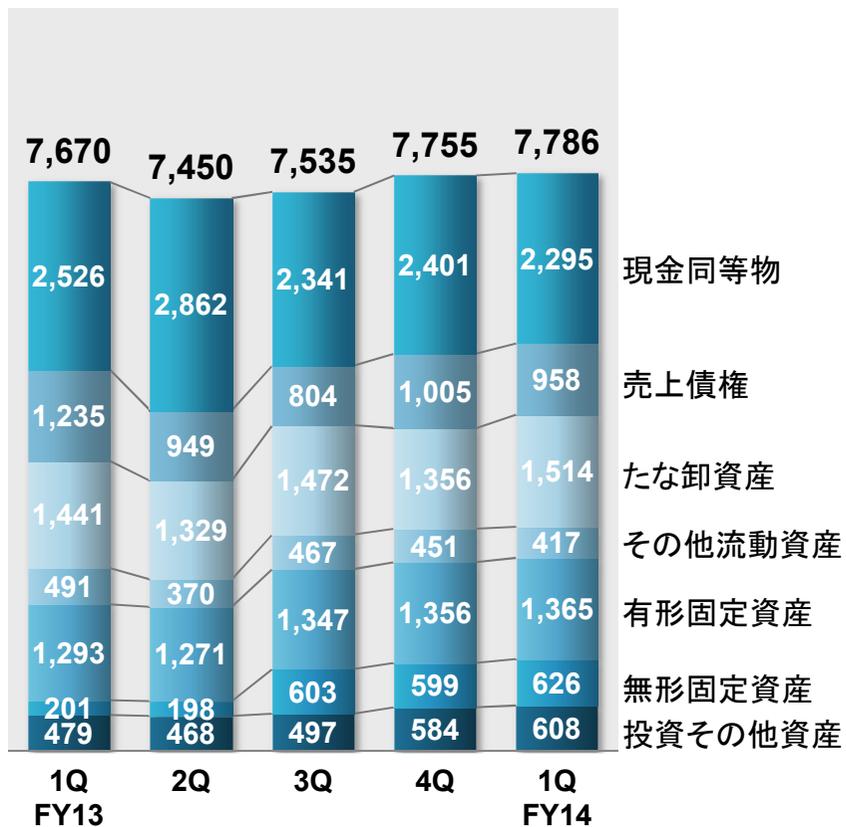


	FY11 1Q	2Q	3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q
■ 国内	256	173	222	439	250	163	149	117	100	163	115	187	183
■ 米国	186	466	245	254	311	248	297	368	240	184	317	249	264
■ 欧州	69	228	141	186	172	39	76	70	68	77	50	77	109
■ 韓国	311	249	210	307	219	179	511	251	97	73	52	105	182
■ 台湾	425	346	382	403	137	66	335	210	200	167	313	410	149
■ 中国・東南ア他	197	263	235	229	125	54	129	74	81	83	100	127	244

貸借対照表

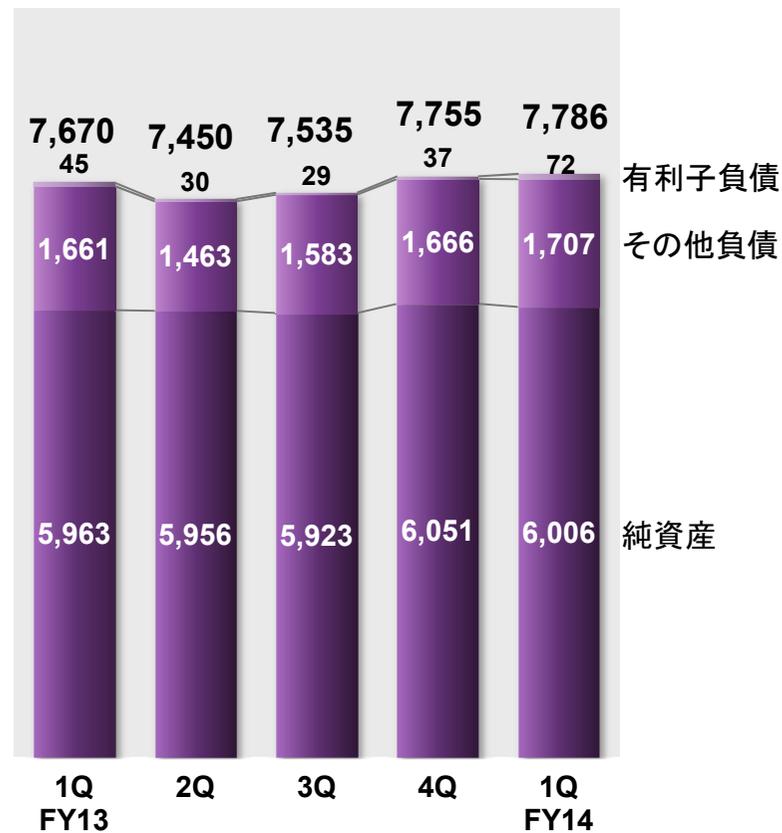
資産

(億円)



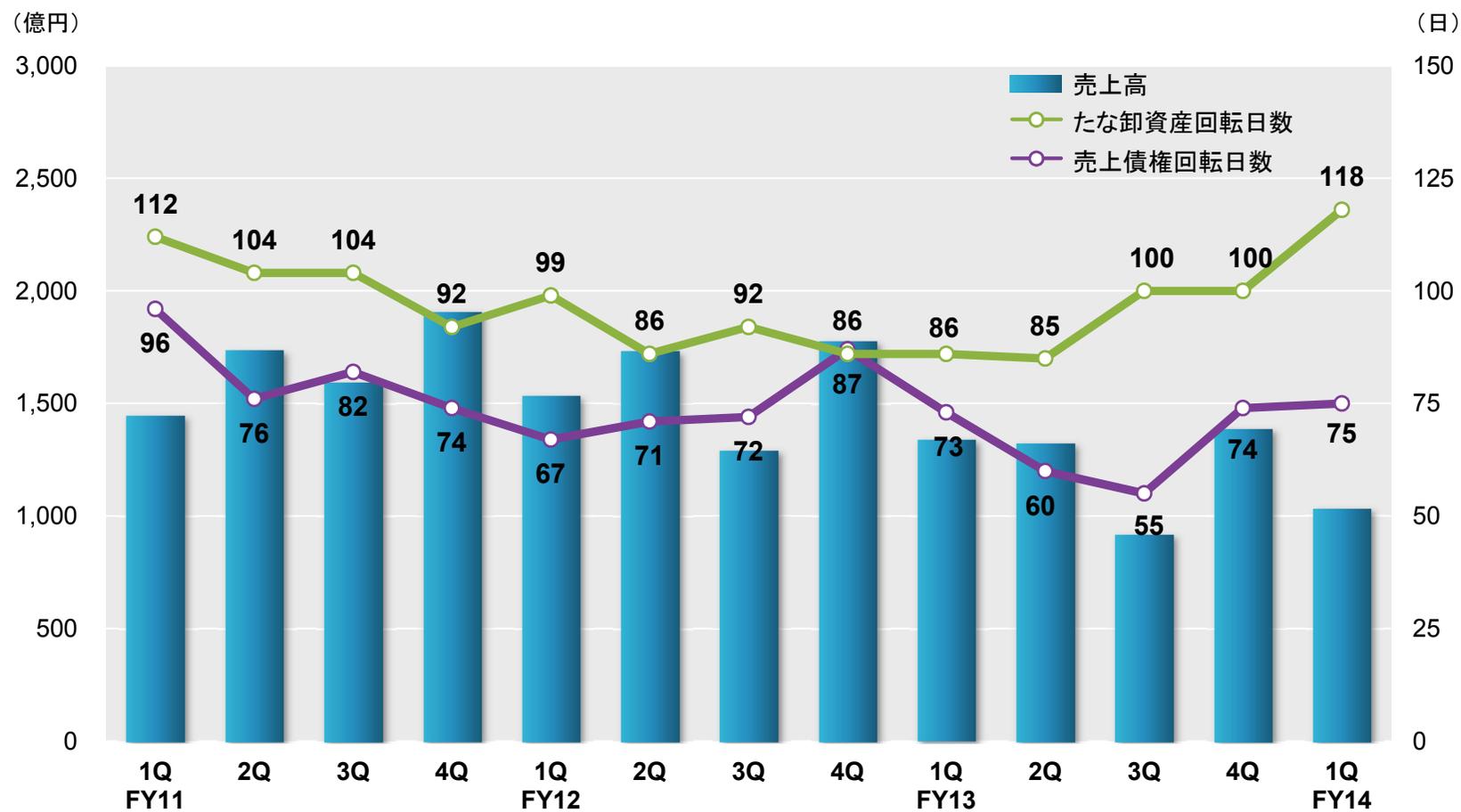
負債・純資産

(億円)



現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

	2013年3月期 1Q	2014年3月期 1Q	(億円)
営業キャッシュ・フロー	358	△13	
税引前利益	112	△98	
減価償却費	55	63	
売上債権の減少(△増加)	260	51	
たな卸資産の減少(△増加)	51	△157	
仕入債務の増加(△減少)	△114	7	
法人税等の支払額または還付額	△52	△17	
その他	45	138	
投資キャッシュ・フロー	△460	132	
設備投資	△73	△32	
企業買収に伴う株式取得等による支出	△158	-	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	△210	176	
その他	△19	△12	
財務キャッシュ・フロー	△48	△14	
配当金支払い	△48	△46	
その他	0	32	
現金及び現金同等物の期末残高	1,428	923	
満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高	1,098	1,371	
現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高	2,526	2,295	



2014年3月期 業績予想修正と中期経営計画

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2013年7月30日

市場環境



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 30, 2013



事業環境 2013年7月時点での見方

▶ 半導体設備投資

CY2013の半導体前工程(WFE)の設備投資は、前年比ほぼ同水準の\$30Bを見込む

- ロジック/ファウンドリ: 先端ロジック向け能力増強投資は継続が見込まれる
- メモリ: スマートフォン、タブレットに牽引され需要が拡大する
NAND: 需給が引き締まり、投資増加を見込む
DRAM: モバイルDRAM向け投資が回復する

▶ FPD設備投資

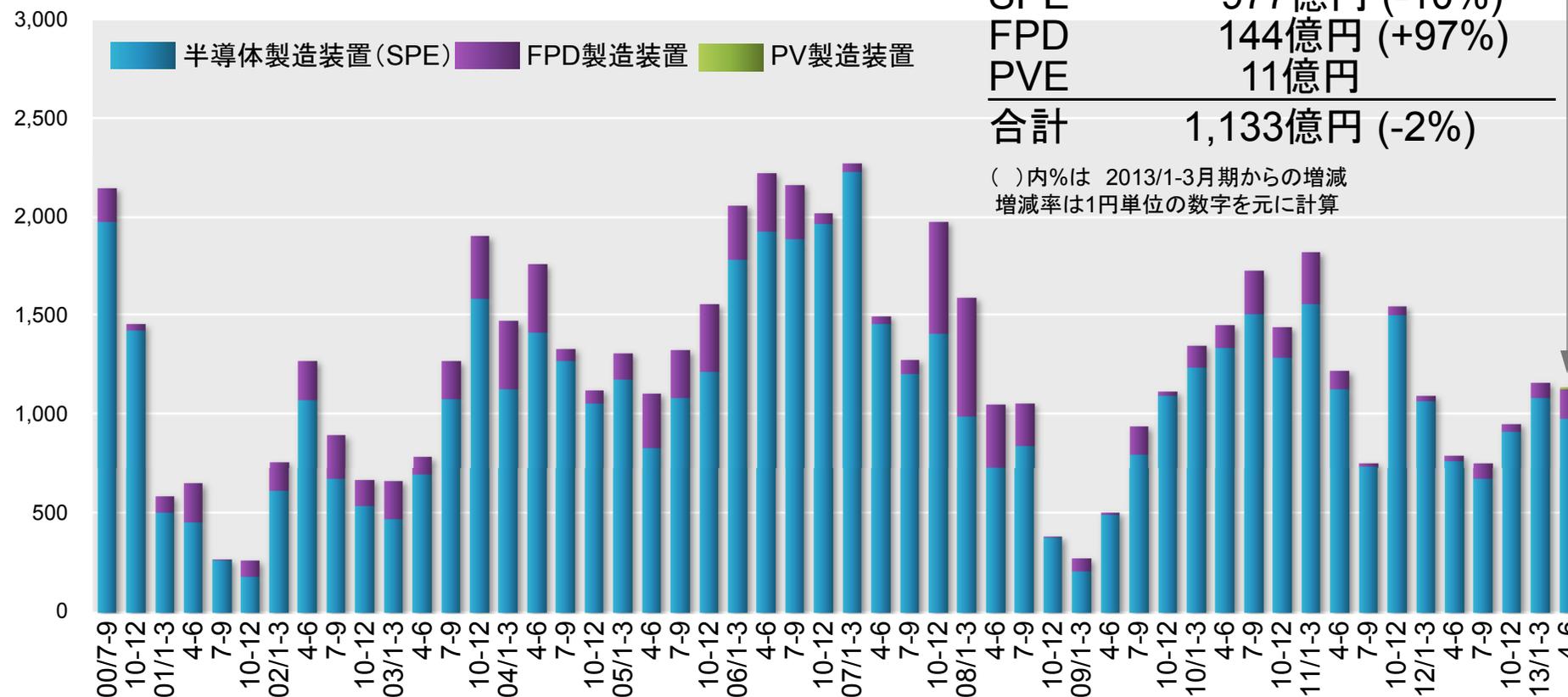
CY2013の液晶パネル用製造装置の需要は、前年比50%前後の増加を見込む。大型パネル向け投資は中国での新規投資再開による改善が見られ、中小型パネル向け投資は継続が見込まれる。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降であり、設備投資の本格化は2015年を見込む。

▶ PV設備投資

太陽光パネル市場は継続的に成長しているものの、供給過剰の状態が続いている。その結果、極端な価格下落がパネルメーカー各社の収益性を依然として圧迫している。このような事業環境下では変換効率を高める技術革新が期待されており、中期的には設備投資は回復するものと予想する。

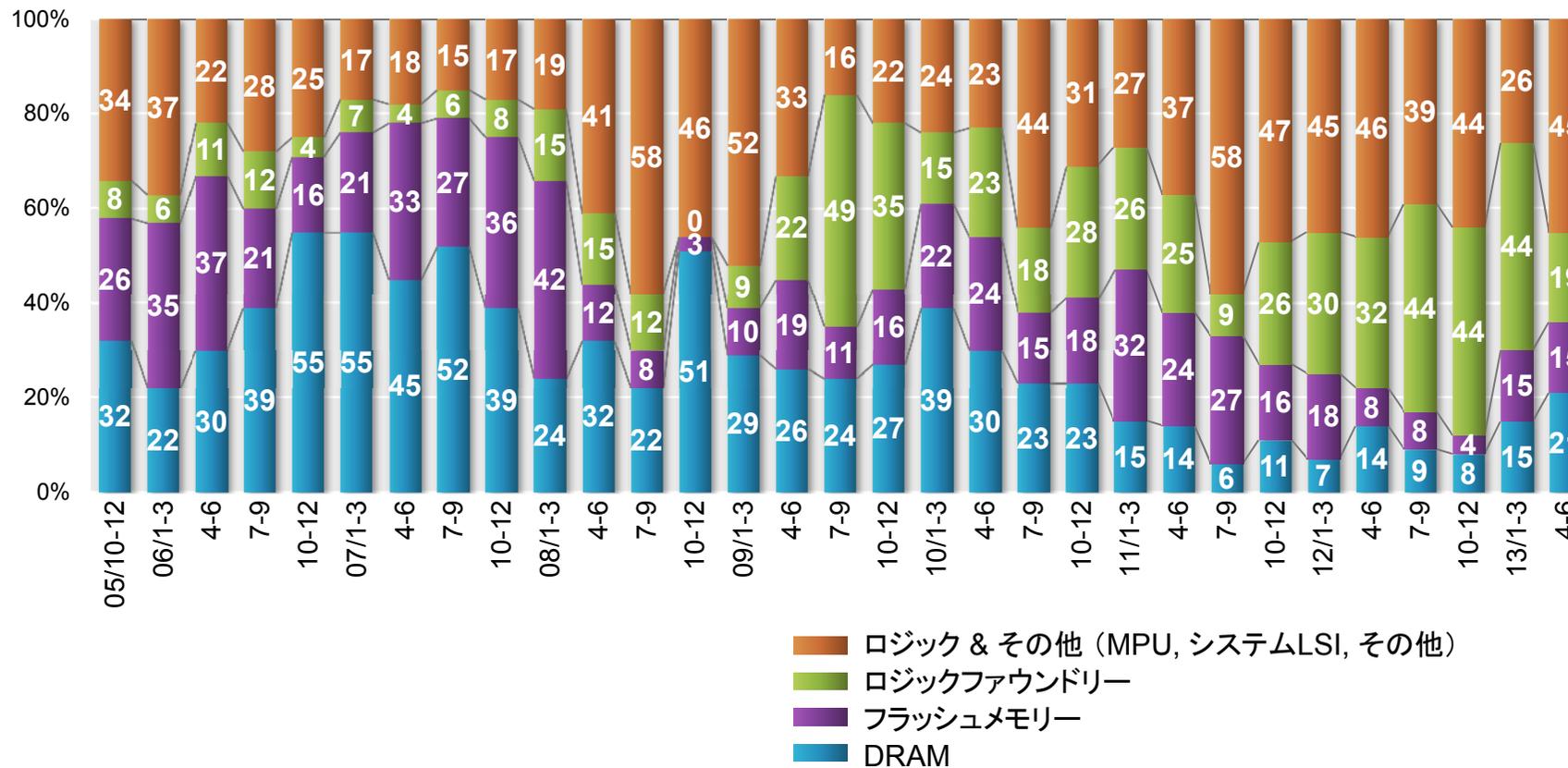
四半期 受注額

(億円)



2012/1-3月期以前のPV製造装置の受注額は
FPD製造装置の値に含まれています。

四半期 アプリケーション別SPE受注



グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

2014年3月期 業績予想修正



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 30, 2013



2014年3月期 業績予想修正

(億円)

	FY2013	FY2014						通期 対前年 増減
		上期		下期		通期		
		新予想	修正額*	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	4,972	2,520	-	3,100	-80	5,620	-80	+13%
SPE	3,920	1,960	+60	2,400	-	4,360	+60	+11%
FPD	200	100	-	160	-	260	-	+30%
PVE	0	40	-60	70	-80	110	-140	-
EC/CN	846	420	-	470	-	890	-	+5%
その他	4	-	-	-	-	-	-	-
営業利益	125	-65	+15	245	-15	180	-	+54
下段:営業利益率	2.5%	-2.6%	+0.6pts	7.9%	-0.3pts	3.2%		+0.7pts
税前利益	177	-55	+15	255	-15	200	-	+22
当期純利益	60	-10	+20	140	-20	130	-	+69

*修正額: 2013/4/30に発表した業績予想からの修正額を示しています。

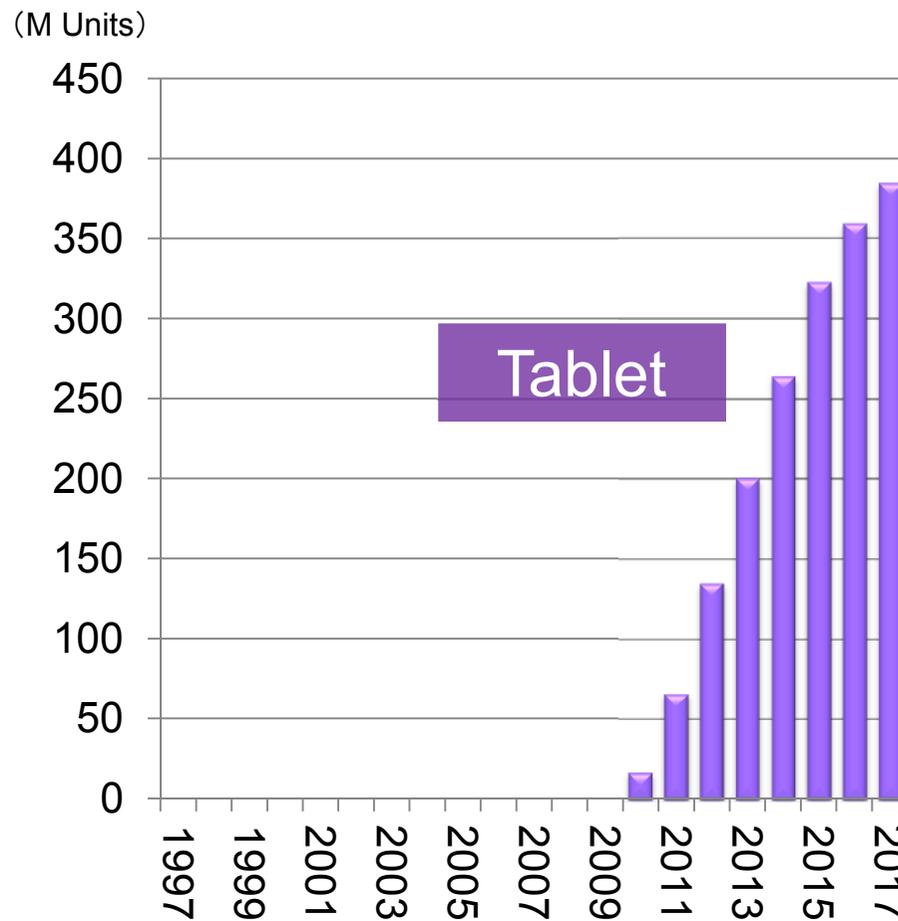
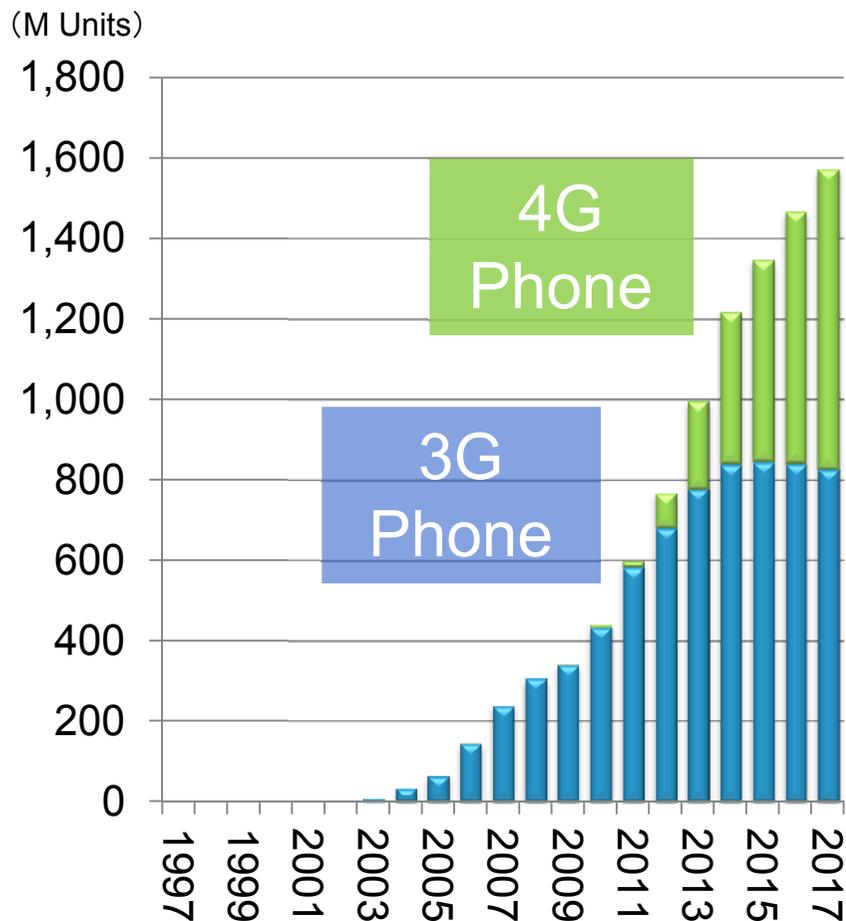
SPEの上期売上およびPVの通期売上を修正

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置 PVE: 太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

18

中期経営計画

モバイル機器が牽引するSPE市場



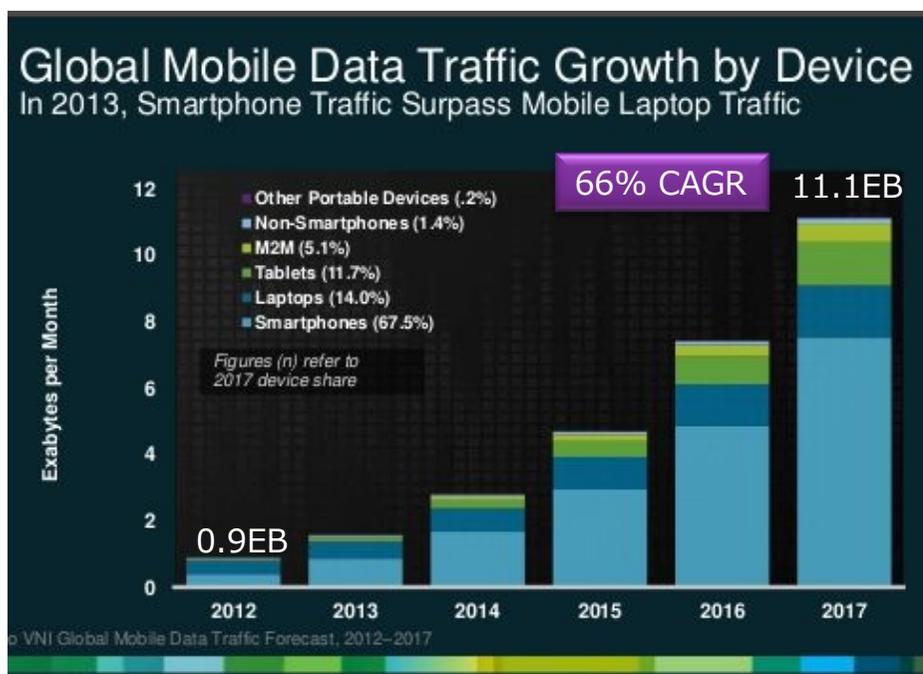
Source: iSuppli, Mar 2013

モバイル機器需要は激増、高機能な機器が成長

増大するデータ通信量

モバイル用途のデータ量は大幅な増加が期待される

– 2012年比で2017年には12.6倍、CAGR66%の爆発的成長



Average Traffic Per Mobile Device Type

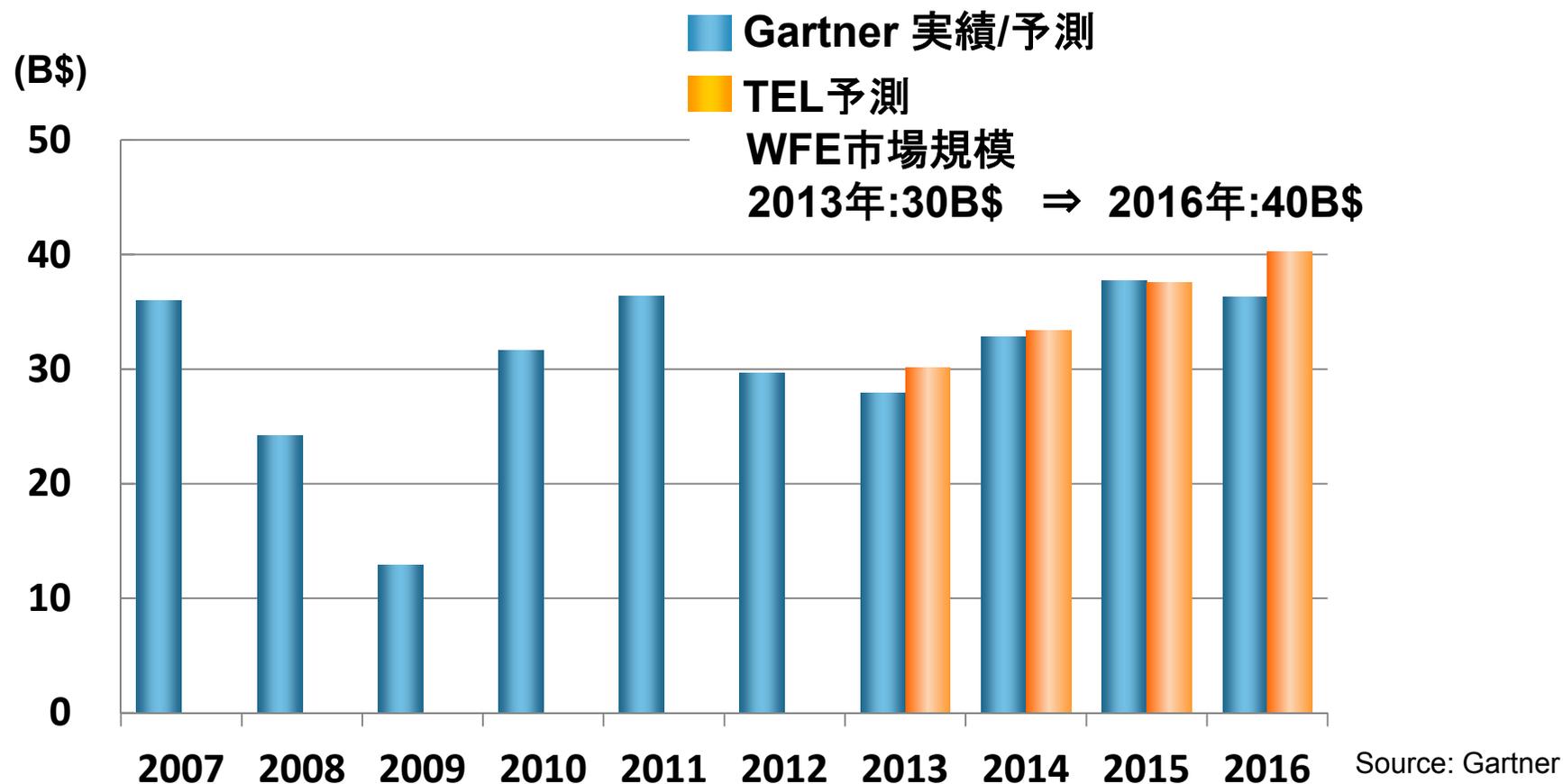
	2012	2017
	MBs per Month	MBs per Month
Non-Smartphone	6.8	31
M2M	64	330
Smartphone	342	2,660
4G Smartphone	1,302	5,114
Tablet	820	5,387
Laptop	2,503	5,731

Source: Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast, 2012-2017

Source: Cisco, Feb 2013

超高速データ処理技術、低消費電力技術のニーズは継続

半導体前工程(WFE)市場



ロジック投資の継続、NAND新工場の投資により
WFE市場は継続的に拡大が見込まれる

22

WFE市場拡大の背景

▶ ロジック

今後も半導体設備投資の過半を占める
FinFETなど高性能な半導体デバイスへの要求が高まる
微細化は7～5nmまで継続

▶ NAND

モバイル機器向け及び、ストレージ市場(SSD)を軸に拡大
2Dから3D-NANDのシフトにより、新棟投資による継続的な市場成長が見込まれる

▶ DRAM

PC需要は伸び悩んでいるが、モバイル機器台数の急増と機器一台あたりの
搭載量の増加により、モバイルDRAM向け設備投資の継続が見込まれる

最新技術トレンドへの当社の対応

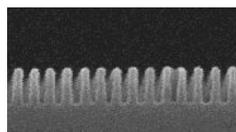
Lithography/Patterning

EUV

- コータ/デベロッパの開発においてimec、SEMATECHとの共同開発を実施中
- 業界をリード

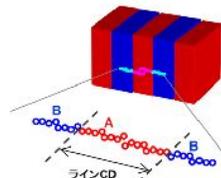
EUV: Extreme Ultraviolet

Multiple patterning



- 4重露光の開発推進
- 当社装置により11nmのパターンを実現

DSA

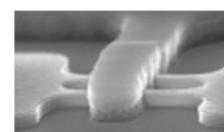


- コンソーシアム、材料メーカー、大学と共同開発中
- 顧客評価中

DSA: Directed Self-Assembly

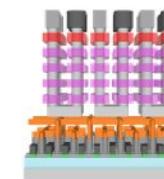
New structures

FinFET



- 量産ラインで採用済み
- 主要顧客と先端開発を実施中

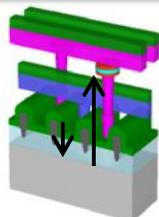
3D NAND



- 顧客評価中
- 主要顧客との共同開発を実施中

New memory

STT-MRAM



- 東北大学、imecとの共同開発を実施
- 装置開発が進行中

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

Advanced packaging

Wafer level packaging/TSV



- 製品ラインアップ拡充のためNEXX Systems社を統合

積極的な技術開発で業界をリード

SPE事業での取り組み

シェア向上

- エッチング装置
 - RLSAエッチング装置によるPolyエッチ市場でのシェア拡大 (FinFETゲート工程)
 - 当社の強みである深掘エッチング技術で3D-NANDでのポジション獲得
- 洗浄装置
 - 枚葉洗浄装置のシェア拡大に注力
 - 微細化に伴う技術への対応でドライ洗浄装置の売上拡大
- 熱処理成膜装置
 - セミバッチ式のALD成膜装置で、枚葉市場での売上拡大

新規分野

- 先端パッケージング分野
 - 製品ラインアップの拡充により中期的に収益拡大を目指す

先端パッケージ分野に向けたTEL製品

Tactras™ FAVIAS
Deep Si etcher



CELLESTA™+
Cleaning



TELINDY PLUS™ VDP
Dielectric liner deposition



Apollo
Physical vapor deposition



CLEAN TRACK™ LITHIUS™ Pro
Patterning



TEL NEXX製品



Stratus
Electrochemical deposition

Synapse™ V
Wafer bonder



Synapse™ Z
Wafer de-bonder



3DI, ウェーハレベルパッケージングにおける製品ラインアップを強化

次世代メモリデバイスの開発

STT-MRAM向け製品ラインアップ



GCIB装置
(TEL Epion)



洗浄装置



エッチング・
CVD装置



磁場アニール装置
(TEL Magnetic Solutions)



酸窒化膜
CVD装置



磁性・金属
スパッタ装置

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

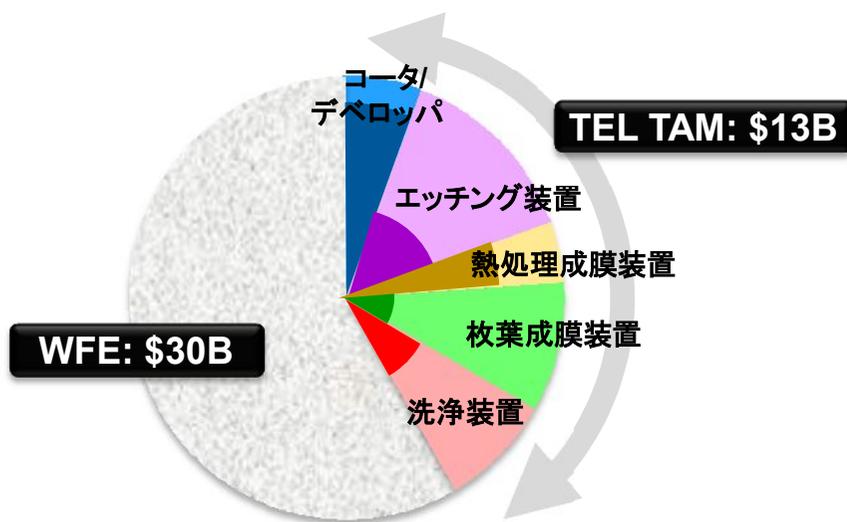
▶ 共同開発



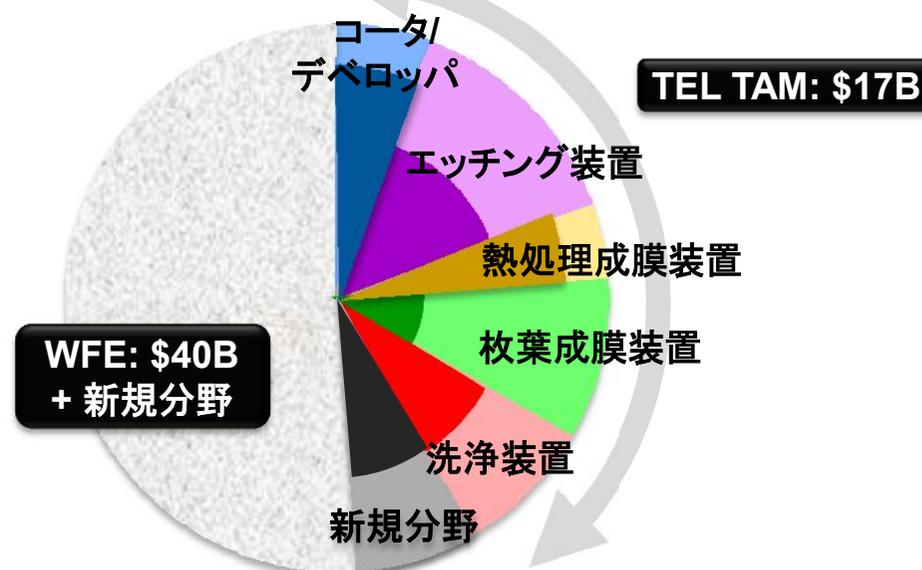
開発加速により、早期量産適用を目指す

SPE事業成長シナリオ

CY2013(2014/3月期)



CY2016(2017/3月期)



➤ SPE ビジネス : 3年で60%の成長

(売上高: 4,360億円 ⇒ 6,900億円)

- ・ 市場拡大による成長 : 30%
- ・ シェア向上による成長 : 15%
- ・ 新規分野による成長 : 15%

FPD事業での取り組み

- ▶ G8向け新型ICPエッチング装置を市場投入し、収益およびシェア拡大を狙う。
- ▶ 2016年より本格化が見込まれる大型TV用有機ELパネル製造に向けて、OLED成膜装置の早期開発を実現し、収益拡大を図る。
- ▶ 中国昆山工場における装置製造により、顧客対応力向上を目指す。また、段階的に現地調達率を高め、利益率改善を図る。



東電光電半導体設備(昆山)有限公司
Tokyo Electron (Kunshan) Limited

ICP: Inductively Coupled Plasma(誘導結合プラズマ)

PV事業での取り組み

薄膜Siの優位性

- ◆ 材料依存度低く、製造工程がシンプル(低コスト)
- ◆ 高温環境や低照度条件下で高い発電性能を発揮
- ◆ 有毒物質、希少材料は不使用

変換効率向上の施策

- 光マネージメント技術
- 半導体製造装置技術を応用
 - プラズマ均一化技術
 - 薄膜均一塗布技術
 - MEMS技術



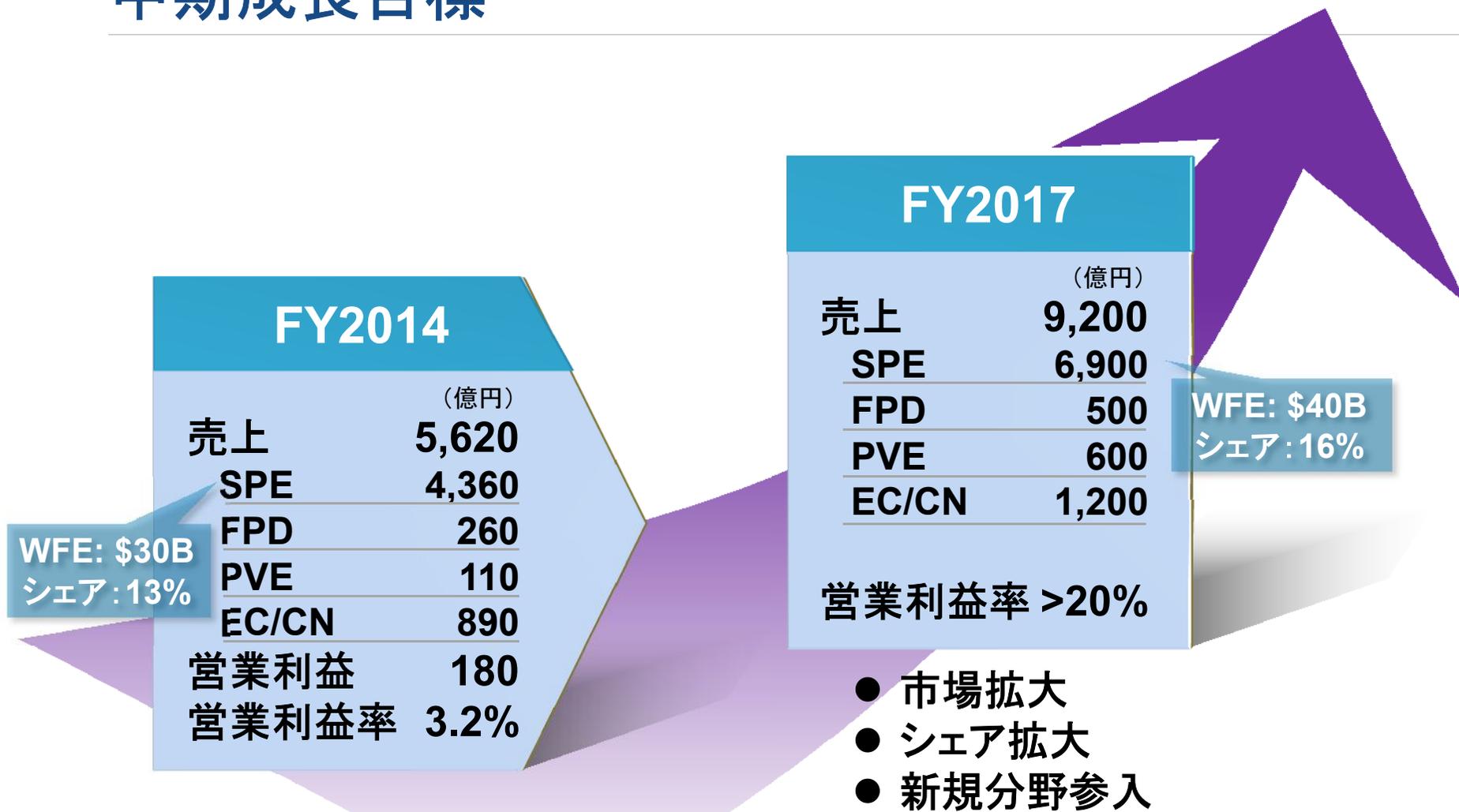
テクノロジーセンターつくば

早期に変換効率向上を達成し、
グリッドパリティを超える製造コスト\$0.4/Wp以下を実現する

収益性向上への取り組み

- ▶ 開発・製造一貫体制によるコスト低減と新生産方式による生産効率化を推進
- ▶ 中国昆山工場におけるFPD装置製造により段階的に現地調達率を高め、利益率改善を図る
- ▶ 開発の効率化を推進
- ▶ 新生産拠点、新開発拠点への大型投資は一巡しており、今後は減価償却費など減少の方向

中期成長目標



SPE事業は営業利益率27%以上、連結では20%以上を目指す

経営方針

- ▶ 技術革新が市場と利益を創造する経営を貫く
- ▶ 顧客第一主義のもと、グローバルレベルで技術サポート力を強化
- ▶ 現場からトップまで、創造性、挑戦意欲、情熱、責任感に満ちた活力のある会社づくり
- ▶ ワールドクラスの高収益体質と更なる成長を実現

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

50 Years